

★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 前澤宏一 副委員長 津田邦男
幹事 松永高治・鈴木寿一 幹事補佐 新井 学・東脇正高

★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 野毛 悟 副委員長 廣瀬文彦
幹事 小館淳一・岩田展幸 幹事補佐 坂本 尊・中村雄一

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大野裕三 副委員長 国清辰也
幹事 黒田理人 幹事補佐 山口 直

日時 5月19日(木) 13:00~16:40
20日(金) 9:30~12:20

会場 静岡大学工学部浜松キャンパス総合研究棟 10F 会議室 (浜松市中区城北 3-5-1. 遠鉄バス乗り場等 JR 浜松駅前
北口バスターミナル 15, 16 番乗り場から全路線「静岡大学」下車 (約 20 分, 1 時間に 10 本程度運行). <http://hama.shizuoka.ac.jp/pages/access/> 高野 泰)

議題 結晶成長, 評価及びデバイス (化合物, Si, SiGe, 電子・光材料) 及びその他

19 日

1. ドライ転写技術によるナノキャピティ上への CVD 単層グラフェンダイアフラムの製作
○石田隼斗・高橋一浩 (豊橋技科大)・澤田和明・石田 誠 (豊橋技科大/アイリス)
2. 熱化学気相成長法による合金基板上へのグラフェン合成
○岸 直希・岩間一樹・水谷拓哉・加藤慎也・曾我哲夫 (名工大)
3. ZnO nanostructures for the fabrication of photoanode towards energy applications
○Mani Navaneethan・Jayaram Archana・Santhana Harish・Tadanobu Koyama・Hiroya Ikeda・Yasuhiro Hayakawa (Shizuoka Univ.)
4. ZnO ナノ構造を用いたフレキシブル材料の熱電特性評価
○和波雅也・セルバラジ シャンティ・鈴木悠平・ベルスワミイ パンディヤラサン (静岡大)・ファイズ サレ (マ
ラヤ大)・下村 勝・村上健司・池田浩也 (静岡大)
5. 絶縁ゲート型トランジスタに向けた絶縁体/窒化物半導体界面形成プロセスの検討
○近藤佐隆・篠原正俊・彦坂朋輝・馬場真人・岡田 浩・関口寛人・山根啓輔・若原昭浩 (豊橋技科大)
6. ダイヤモンドショットキーバリアダイオードによるレクテナ回路の作製
○河野直士・嘉数 誠・大石敏之 (佐賀大)
7. パリレン薄膜を用いたアルミサブ波長格子によるプラズモニクカラーシートの製作
○熊谷隼人 (豊橋技科大)・本間浩章 (豊橋技科大/学振)・石田 誠・澤田和明 (豊橋技科大/アイリス)・高橋
一浩 (豊橋技科大)
8. セリウム置換イットリウム鉄ガーネットを用いた近赤外波長域用磁性フォトニック結晶の形成に関する研究
○吉本拓矢・後藤太一・高木宏幸・内田裕久・井上光輝 (豊橋技科大)

20 日

1. EDTA を錯化剤に用いた溶液成長法による SnS 薄膜堆積 ○神田祐作・高野 泰・石田明広 (静岡大)
2. 光化学堆積法による透明な p 型半導体薄膜 $\text{Cu}_x\text{Zn}_y\text{S}$ の熱処理 ○トン バインガルディ・市村正也 (名工大)
3. Evaluation of electrical properties of HfS_2 thin flakes obtained by mechanical exfoliation
○Vikrant Upadhyaya・Toru Kanazawa・Yasuyuki Miyamoto (Tokyo Inst. of Tech.)
4. $\text{Si}(111)-\sqrt{3}\times\sqrt{3}\text{-Ga}$ 表面上への GaSb 薄膜のヘテロエピタキシャル成長
下山浩哉・○森 雅之・前澤宏一 (富山大)
5. Gravity effect on the properties of $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{Sb}$ ternary alloys grown at the International Space Station
○Velu NirmalKumar (Shizuoka Univ.)・Mukannan Arivanandhan (Anna Univ.)・Govindasamy Rajesh・Tada
nobu Koyama・Yoshimi Momose (Shizuoka Univ.)・Kaoruho Sakata (Univ. of Tokyo)・Tetsuo Ozawa (Shizu
oka Insti. Sci. & Tech.)・Yasunori Okano (Osaka Univ.)・Yuko Inatomi (JAXA)・Yasuhiro Hayakawa (Shizu
oka Univ.)
6. 高品質 III-V-N/Si ヘテロエピタキシーのための界面制御技術とデバイス応用
○山根啓輔・佐藤健人・後藤聖也・関口寛人・岡田 浩・若原昭浩 (豊橋技科大)

☆ED 研究会

【問合先】

松永高治 (NEC)

TEL [044] 435-8348, FAX [044] 455-8253

E-mail : k-matsunaga@fp.jp.nec.com

鈴木寿一 (北陸先端大)

TEL [0761] 51-1441, FAX [0761] 51-1455

E-mail : tosikazu@jaist.ac.jp

☆CPM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

6月17日(金) 機械振興会館〔締切済〕テーマ：材料・デバイスサマーミーティング

【問合せ先】

中村雄一 (豊橋技科大)

TEL [0532] 44-6734, FAX [0532] 44-6757

E-mail : nakamura@ee.tut.ac.jp

☆SDM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

6月29日(水) キャンパス・イノベーションセンター東京〔締切済〕テーマ：MOS デバイス・メモリ高性能化—

材料・プロセス技術 (応用物理学会；シリコンテクノロジー分科会合同開催)

【問合せ先】

黒田理人 (東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail : rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp